

specificazioni	
Modello di prodotti	RQ5E070BNTCL
fabbricante	LAPIS Semiconductor
Descrizione	NCH 30V 7A MIDDLE POWER MOSFET
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	3248 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	2.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	TSMT3
Serie	-
Rds On (max) a Id, Vgs	16.1 mOhm @ 7A, 10V
Dissipazione di potenza (max)	1W (Tc)
imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	SC-96
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	950pF @ 15V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Tensione drain-source (Vdss)	30V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	7A (Tc)

   RQ5H020TN ROHM RQ5H020TN ROHM	   RQ5H020TNTR ROHM RQ5H020TNTR ROHM	   RQ5E040TN ROHM RQ5E040TN ROHM	   RQ5E040RP ROHM RQ5E040RP ROHM
   RQ5E050ATTCL ROHM ROHM TSMT3	 RQ5H020SP ROHM RQ5H020SP ROHM	   RQ5H020TN MOS ROHM ROHM SOT-23	 RQ5H020SPTL Rohm Semiconductor MOSFET P-CH 45V 2A TSMT

Di Più

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**
 AGGIUNGI: Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.
 Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited